PAT-NO:

1

JP402082696A

DOCUMENT-

JP 02082696 A

IDENTIFIER:

TITLE:

METAL THIN FILM LAMINATE STRUCTURE FOR

ELECTROMAGNETIC WAVE SHIELD

PUBN-DATE:

March 23, 1990

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

OIKE, HITOSHI

YANAGIMACHI, MOTONARI

ANAYAMA, KOJI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

OIKE IND CO LTD N/A

APPL-NO: JP63235845

APPL-DATE: September 20, 1988

INT-CL (IPC): H05K009/00

US-CL-CURRENT: <u>174/35R</u>, <u>361/818</u>

ABSTRACT:

PURPOSE: To improve flexibility and electromagnetic wave shielding characteristics by providing a metal thin film layer on opposite surfaces of a very flexible non-conductive base.

3/11/05, EAST Version: 2.0.1.4

0

CONSTITUTION: For a non-conductive base 11 for use in a metal thin film laminate structure for shielding electromagnetic waves, there are for example available fabrics, knits, and unwoven fabrics comprising fibers such as polyethylene terephthalate, polyphenylene oxide, and rayon, etc., and further Japanese paper, machine-made paper, and synthetic paper, etc. For the metal thin film layer 2 there are available conductive materials such as metals of aluminum, copper, lead and niobate, etc., and alloys including those metals. The metal thin film layer 2 is deposited in a vacuum on the opposite surfaces of the non-conductive base 1 by vacuum deposition or ion plating. Hereby, electric apparatus, insulated electric wires, and magnetic recording media can be protected from any influence of the electromagnetic waves to also improve flexibility.

COPYRIGHT: (C)1990,JPO&Japio

B 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

◎ 公 開 特 許 公 報(A) 平2-82696

®Int. Cl. ⁵

識別記号

庁内整理番号

43公開 平成2年(1990)3月23日

H 05 K 9/00

R 7039-5E

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

図発明の名称 電磁波シールド用金属薄膜積層体

②特 願 昭63-235845

均

20出 顧 昭63(1988) 9月20日

@発明者 尾池

京都府京都市右京区梅津大縄場町6-6 嵐山ロイアルハ

イツ3-1104

⑩発明者 柳町 元成

京都府京都市伏見区深草大亀谷大山町21番地1号 コーポ

ラス松井305

@発明者 穴山

弘 司

京都府京都市西京区樫原前田町17-8

⑪出 願 人 尾池工業株式会社

京都府京都市下京区仏光寺通西洞院入木賑山町181番地

明細:檀

1 発明の名称

電磁波シールド用金属薄膜積層体

2 特許請求の範囲

非導電性基材の両面に、金属糠膜層を設けたことを特徴とする電磁被シールド用金属糠膜積層体。

3 発明の詳細な説明

、〔技術分野〕

本発明は、電磁被シールド用金属薄膜積層体に関するものである。さらに詳しくは、エレクトロニクス機器のハウジング、絶縁電線、電力ケーブルの被覆、建材(床、壁、天井、カーテンなど)などに使用したり、電子機器および磁気記録体などを包装する電路被シールド用金属薄膜積層体に関するものである。

[従来の技術]

従来から、エレクトロニクス機器の発達普及に 件い、これらの機器および磁気記録体などを、静 電気および電磁波の悪影響から保護することが必 要になり、この保護材料として電磁波シールド用 シート材料ないしは包装用シート材料の需要が拡 大している。

従来、エレクトロニクス機器、絶縁電線、電力ケーブル、磁気記録体などを電磁被や静電気の影響から保護するために、カーボンブラック、カーボン槌組、金属短線維、金属燐片または金属粉末を含有する導電性材料を含む導電性シートが知られている。

[発明が解決しようとする問題点]

しかしながら、上記従来の導電性シートはつぎ のごとき欠点を有する。

つまり、このような従来の基電性シートは、エレクトロニクス機器、絶縁電線、電力ケーブル、 磁気記録体などを電磁波の影響から保護する目的 には充分に効果があるとはいえないものであり、 かつ、その可視性が不充分で、保護すべき機器の 形状にフィットしにくいものであった。

さらにまた、合成樹脂フイルムの片面に金属顔 膜層を蒸着形成した積層シートも知られていて、 この積層シートは可撓性に優れエレクトロニクス 機器、絶縁電線、電力ケーブル、磁気記録体など の被覆包装用に用いるのに適しているが、電磁波 シールド特性が不充分であるという問題点があった。

採用し、しかもその金属薄膜層をポリエチレンテ レフタレート、ポリフェニレンオキサイド、ポリ イミド、ポリフェニレンサルファイド、ポリブチ レンテレフタレート、ポリアミド、ポリプロピレ ン、ポリエチレン、ポリスチレン、ポリ塩化ビニ ル、ポリ塩化ビニリデン、ポリ酢酸ビニル、ポリ メチルメタクリレート、エチレンー能能ビニル共 重合体、ABS樹脂、ポリアセタール、ポリカー ボネートなどのプラスチックフィルムや、紙、機 物、細物、不識布などの可撓性に富んだ非導電性 基材の両面に設けるようにしたので、従来の電磁 波シールド件を有する金属ホイルに、合成樹脂フ イルムを貼着した金属ホイル積層シートが硬く可 捻性が不充分で、この積層シートをエレクトロニ クス機器、絶縁電線、電力ケーブル、磁気配録体 などの被覆包装用に用いても、これらの機器にフ ィットせず、しかも屈曲、折り曲げにより金属ホ イルが容易に折損したり、折れ目が残ったり、積 層構成層が互いに他の構成層から剝離したりする という問題点があったのをことごとく解消できた

本発明は前記の種々の問題点を完全に解消した 電磁波シールド用金属海膜積層体を提供すること にある。

[周囲点を解決するための手段]

[作用]

本発明の電磁放シールド用金属薄膜積層体においては、従来の金属ホイルにかえて金属薄膜層を

のである.

太帝町の、電路被シールド田金属離腹路層体にお いて用いる非導電性基材(1)としては特に削限は ないが、たとえばポリエチレンテレフタレート、 ポリフェニレンオキサイド、ポリイミド、ポリフ ェニレンサルファイド、ポリブチレンテレフタレ ート、ポリアミド、ポリプロピレン、ポリエチレ ン、ポリスチレン、ポリ塩化ピニル、ポリ塩化ビ ニリデン、ポリ酢酸ピニル、ポリメチルメタクリ ·レート、エチレンー酢酸ビニル共重合体、ABS 樹脂、ポリアセタール、ポリカーボネートなどの プラスチックフィルムや、ポリエステル、ポリア ミド、ポリアミドイミド、ポリエチレン、ポリブ ロピレン、セルロースアセテイト、ポリカーボネ ート、ポリ塩化ビニル、アクリル、レーヨンなど の繊維からなる織物、鉱物、不維布や、和紙、洋 紙、合成紙などが適宜用いられる。

非導電性基材(1) の厚さとしては特に制限はないが、たとえば通常 2 μm ~ 5 mm程度、好ましくは厚さが 6 μm ~ 500 μm 程度の厚さのものが用いられ

る。厚さが 2mm未満では柔らか過ぎてしわが発生したり、加工むらを生じやすく、製品ロスも増加するため実用性がなく、一方厚さが 5mmを超えると柔軟性に乏しく硬い電磁被シールド用金属薄膜 積層体となるため特殊な用途以外には不向きで実用性に乏しい。

非導電性基材(1) が金属態膜層(2) との密着性に劣るものである場合にはあらかじめ下盤層(3)を設けておくのが舒ましい。

下塗層(3) の厚さとしては特に制限はないが通常 0.1~ 2 pm 程度である。

下塗層(3) を形成する塗料としては、たとえばボリエステル、ポリアミド、ポリアミドイミド、ボリエチレン、ボリブロピレン、セルロースアセテイト、ニトロセルロース、ボリカーボネート、ボリ塩化ピニル、アクリル樹脂、アクリル酸低級アルキルエステル樹脂、ウレタン樹脂、尿素ーメラミン樹脂、エボキシ樹脂、アミノール樹脂などの樹脂やSBR、NBR、NR、シリコンゴムなど

なお、金属薄膜層(2) は一旦仮の担持体上に形成した金属藤膜層を接着剤を介し又は介さずして 前記非導電性基材(i) 上に転写形成するようにし てもよい。

金属障膜層(2) は一般に物理的、化学的損傷を受け易いので上塗層(4) が設けられるのが普通である

上塗層(4)を形成する塗料としては、たとえばボリエステル、ボリアミド、ボリアミドイミア・ボリエチレン、ボリプロピレン、セルロースアイト、ニトロセルロース、ボリカーボネート、ボリ塩化ピニル、アクリル樹脂、アクリル酸低級アルキルエステル樹脂、ウレタン樹脂、尿素ーメラミン樹脂、エボキシ樹脂、アミノール樹脂などの樹脂やSBR、NBR、NR、シリコンゴムなどの合成ゴムの1種もしくは2種以上の混合物が用いられる。

上盤層(4) の厚さは通常 0.1 pm ~ 2 pm 程度である。

の合成ゴムの 1 種もしくは 2 種以上の混合物が用いられる。

本免明の電磁被シールド用金属離膜積層体にお いて、従来の金属ホイルにかえて用いる金属薄膜 層(2) としては特に創展はないが、本発明におい て金属慈膜層(2)としては、通常アルミニウム、 銅、ニッケル、亜鉛、錫、銀、金、インジウム、 クロム、白金、鉄、コバルト、モリブデン、チタ ン、ベリリウム、バラジウム、タンタル、鉛、ニ オブなどの金属、それらの金属をふくむ合金など の導電性を有するものが真空蒸着法、スパッタリ ング法、イオンプレーティング法などの通常の方 法によって前記非導電性基材(1)の両面上に前記 下盤層(3)を介しあるいは介さずして蒸着形成さ れ、その厚さが通常 Insa~ 500ns程度のものが好 ましい。厚さが通常 inm未満では充分なシールド 効果が得られず、 500n■を超えてもシールド効果 に差が生じないことおよび得られる電磁被シール ド用金属薄膜積層体が可撓性に欠けるので好まし くない。

本発明のこのようにして得られた電磁波シールド用金属薄膜積層体はそのまま用いてもよく、またこれらを細幅に裁断したものをそのまま糸として、あるいは他の普通糸と引き揃えたり、 燃糸したり、 絡ませたりした糸を用いて電磁波シールド用の織物、 編物、 不織布として用いることもできる。

[実施例]

つぎに実施例をあげて本発明を説明する。 実施例 1

厚さ 9点のポリエチレンテレフタレートフイルムの両面にそれぞれアルミニウム薄膜層を抵抗加熱真空蒸着法で厚さ 100mmに形成し、本発明の電磁波シールド用金属薄膜積層体を得た。

得られた本発明の電磁波シールド用金属薄膜積 層体は、エレクトロニクス機器、絶縁電線、電力 ケーブル、磁気記録体などを電磁波の影響から保 譲する目的には充分な効果があり、その上可続性 も充分で保護すべき機器の形状に良くフィットし て、10日間経過後も目視によるテストではその金 **届表面に変化は認められなかった。**

实施例 2

厚さ12㎞のポリエチレンテレフタレートフイルムの片面にアルミニウム雄膜層を抵抗加熱真空蒸 着法で厚さ 100nmに形成し、他の片面に銅薄膜層をスパッタリング法で厚さ 200nmに形成し、本発明の電磁被シールド用金属薄膜積層体を得た。

得られた本発明の電磁放シールド用金属薄膜積 層体は、エレクトロニクス機器、絶縁電線、電力 ケーブル、磁気記録体などを電磁波の影響から保 譲する目的には充分な効果があり、その上可撓性 も充分で保護すべき機器の形状に良くフィットす るものであった。

実施例3

実施例 1 で得たアルミニウム両面蒸着ポリエチレンテレフタレートフイルムの片面のアルミニウム時限層上にさらに塩化ビニルー酢酸ビニル共重合体の溶剤溶液をグラビアコーティング法で塗布乾燥して厚さ 1 μμの上塗層を形成し、本発明の電磁波シールド用金属薄膜積層体を得た。

ケーブル、磁気記録体などを電磁波の影響から保護する目的には充分な効果(実施例2のものと同程度)があり、その上可撓性も充分で保護すべき機器の形状に良くフィットして、10日間経過後も目視によるテストではその金属要面に変化は認められなかった。

実施例5

得られた本発明の電磁波シールド用金属態膜積層体は、エレクトロニクス機器、絶量電線、電力ケーブル、磁気記録体などを電磁波の影響から保護する目的には充分な効果(実施例1のものと同程度)があり、その上可撓性も充分で保護すべき機器の形状に良くフィットして、10日間経過後も目視によるテストではその金属表面に変化は認められなかった。

实施例 4

実施例2の銅スパッタリングの前処理としてエポキシーメラミン樹脂の溶剤溶液をロールコーティング法で塗布乾燥して厚さ 1mmの下塗層を形成した後、銅薄膜層をスパッタリング法で厚さ 200 naに形成した。さらに銅薄膜層上に、ベンゾトリアゾール系樹脂の溶剤溶液をグラビアコーティング法で塗布乾燥して、厚さ 0.5mmの上塗層を形成し、本発明の電磁波シールド用金属薄膜積層体を得た。

得られた本発明の電磁波シールド用金属薄膜積 層体は、エレクトロニクス機器、絶経電線、電力

得られた木足明の電磁波シールド用金属離膜積層体は、エレクトロニクス機器、絶縁電線、電力ケーブル、磁気記録体などを電磁波の影響から保護する目的には充分な効果があり、その上可撓性も充分で保護すべき機器の形状に極めて良くフィットして、30日間経過後も目視によるテストではその金属表面に変化は認められなかった。

比較例 1

厚さ 9μmのポリエチレンテレフタレートフイルムの片面にアルミニウム競膜層を抵抗加熱真空蒸 若法で厚さ 200nmに形成し、電磁波シールド用金 属鎌膜積層体を得た。

得られた本発明の電磁波シールド用金属薄膜積 層体は、エレクトロニクス機器、絶縁電線、電力 ケーブル、磁気記録体などを電磁被の影響から保 護する目的にはその効果は充分でなく不満があっ たが、可撓性は充分で保護すべき機器の形状に良 くフィットし、10日間経過後も目視によるテスト ではその金属表面に変化は認められなかった。

比較例 2

厚さ12㎞のポリエチレンテレフタレートフイルムの片面に、銅苺股層をスパッタリング法で厚さ200mmに形成し、さらに同じ面上にアルミニウム苺膜層を抵抗加熱真空蒸着法で厚さ 100mmに形成し、電磁波シールド用金属苺脱積層体を得た。

得られた本発明の電磁波シールド用金属確膜積 層体は、エレクトロニクス機器、絶縁電線、電力 ケーブル、磁気配録体などを電磁波の影響から保 譲する目的にはその効果に不満があったが、可撓 性は充分で保護すべき機器の形状に良くフィット し、10日間経過後も目視によるテストではその金 屈衷面に変化は認められなかった。

比較例 3

厚さ 8μμのポリエチレンテレフタレートフイルムの片面に厚さ 7μμのアルミニウムホイルをドライラミネート法により貼り合わせて、電磁波シールド用金属雄膜積層体を得た。

得られた本発明の電磁放シールド用金属態膜積層体は、エレクトロニクス機器、絶縁電線、電力ケーブル、磁気記録体などを電磁波の影響から保

のとの電磁波シールド特性を表一1に示した。

電磁波シールド特性は、社団法人関西電子振興センター、KEC法(電界モード)にて 1~1000 MHz の範囲で測定した。

[発明の効果]

実施例1~5 および比較例1~4 から明らかな通り、本発明の電磁被シールド用金属薄膜積層体は、エレクトロニクス機器、絶縁電線、電力ケーブル、磁気記録体などを電磁被の影響から保護する目的には充分な効果があり、その上可撓性も充分で、保護すべき機器の形状にフィットしやすいものであった。

表ーし

		電磁波シーパ	電磁波シールド特性(dB)	
		20 MHz	100 M ff z	
建	1	86.9	67.7	
	2	1-21.3	98.0	
比較例	1	66.0	51.3	
	2	100.0	85.7	
	3	112.3	98.7	
	4	118.8	109.7	

設する目的には充分な効果があり、その上10日間 経過後も目視によるテストではその金属裏面に変 化は認められなかったが、可撓性に欠け保護すべ き機器の形状にフィットせず、使用しづらいもの であった。

比較例 4

厚さ12μmのポリエチレンテレフタレートフイルムの片面に厚さ 9μmの銅ホイルをドライラミネート法により貼り合わせて、電磁被シールド用金属雄膜積層体を得た。

得られた本発明の電磁波シールド用金属薄膜積層体は、エレクトロニクス機器、絶縁電線、電力ケーブル、磁気配縁体などを電磁被の影響から保護する目的には充分な効果があったが、10日間経過後には目視によるテストでその金属表面に変化が認められ耐食性に欠け、その上、可撓性にも欠け保護すべき機器の形状にフィットせず、使用してらいものであった。

実施例 1、実施例 2 で得られた本発明の電磁波 シールド用金属薄膜積層体と、比較例 1 ~ 4 のも

[発明の効果]

実施例1~5 および比較例1~4から明らかな通り、本発明の電磁被シールド用金属薄膜積層体は、エレクトロニクス機器、絶疑電線、電力ケーブル、磁気記録体などを電磁波の影響から保護する目的には充分な効果があり、その上可镜性も充分で、保護すべき機器の形状にフィットしやすいものであった。

4 図面の簡単な説明

第1図は本発明の電磁被シールド用金属薄膜積 層体の基本構成を示す機略斜視図であり、第2図 は本発明の電磁被シールド用金属薄膜積層体の基 本構成を示す機略部分拡大断面図であり、第3図 は本発明の電磁被シールド用金属薄膜積層体の他 の実施度様を示す機略部分拡大断面図である。

(図筋の符号)

(1). : 非導電性基材

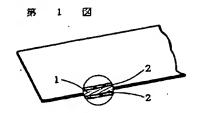
(2):金属莓膜層

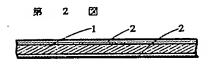
(3):下敛股

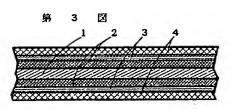
特開平2-82696(6)

(4):上遠層

特許出願人 尾池工業株式会社







- (1): 非導電性基材 (2): 金属薄膜層 (3): 下塗層 (4): 上塗層